# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

05039966

**PUBLICATION DATE** 

19-02-93

APPLICATION DATE

07-08-91

APPLICATION NUMBER

03197626

APPLICANT:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD;

INVENTOR :

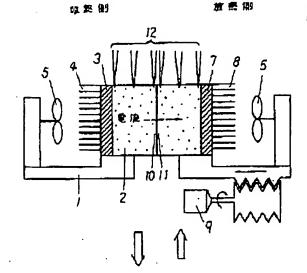
NAKAGIRI YASUSHI;

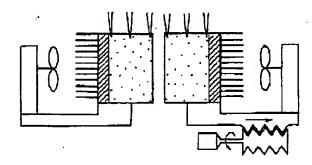
INT.CL.

F25B 21/02 F24F 1/00

TITLE

HEAT PUMP DEVICE





ABSTRACT : PURPOSE: To greatly heighten the utility of the title device using Peltier effect by sharply improving critical efficiency settled by a performance index for a thermoelectric material used, with regard to the improvement of a heat pump.

> CONSTITUTION: For a definite time, an electric current is applied to a heat-radiation device composed so as to be the same as a heat-absorption device, which consists of a semiconductor 2, a copper plate 3 used as an electrode and heat-exchange fins 4, in the state in which one semiconductor end-surface 10 is electrically joined to the other. After that, the heat-radiation device is spatially separated from the end-surface 10 by a driving motor 9 and heat in these semiconductors is isolated each other before each interior of these semiconductors respectively reaches a thermally stable state.

COPYRIGHT: (C) JPO

## (19) [1本[[終]] (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出戰公開番号

## 特開平5-39966

(4以)公開日 平成5年(1993)2月19日

(51) Int. CL\* F 2 5 B 21/02 介州按八帝号

A 5252-3L

F24F 1/00

(803-31, 351

技術表示關係

密在語彙 未請求 請求項の数2(金 5 頁)

(21)出與番号

**持数**平3-197026

松下水器產業株式会社

大阪府門資市大学門共1006番地

(22) 出城日

平成3年(1991)8月7日

(72) 免明者 行天 久朗

大阪府門真市大学門真1006番地 松下電器

和来称人会社内

(72)発明者 山本 義明

大阪府門真市大字門真1000番地 松下電器

经常株式会社内.

(72)発明者 西脇 文俊

大阪府門食市大学門真1006沿地。 松下電器

应总株式会社内

(74)代理人 介理上 小銀治 明 (外2名)

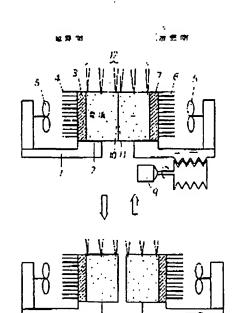
最終点に続く

#### (51) 【発明の名称】 ヒートボンブデバイス

### (57) 【型約】

【川的】 本発明はヒートポンプの改良に関し、川いる 熱電材料の性能指数によって決まっていた効率の観界を 大幅に改善し、ベルチェ効果を利用したヒートポンプデ パイスの有用性を飛締的に高めることを目的とする。

【構成】 半導体2と、電板として用いた銀ブレート 3、および熱交換フィンイからなる吸熱館デバイスと同 じ構成の放熱側デバイスを半導体機面 1 0が飛気的に接 合した状態で一定時間通電した後、内部が然的定常状態 に達する前に駆動モーター9で増順から空間的に切り離 して互いを断熱する。



(特許請求の範別)

(請求項1) ベルチェ効果を有する急戦材料と、それに 型版を通じる手段と、

1

熱歌材料の電視液入例と流出側の間を断急する手段と、 電流供給手段を有することを特徴とするヒートポンプデ パイス。

【請求項2】 熱電材料の電流流入棚と設出網とを断熱する手段が、空間的に両部を分離することである請求項1 記載のヒートポンプデバイス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【廃棄上の利用分野】本発明はベルチェ効果を利用し、 特に電気的に治房もしくは服房を行う空調要費に使用するヒートポンプデバイスに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、電気を熱に変換するヒートポンプ デバイスの基本構成は、図4に示すように電機置子を楽 わた金属板13、及び金属板14によって熱電材料であるN型半導体15、もしくはP型の半導体16を挟み込み、電波を通ずることによりベルチェ熱によって加熱、 治却を行うものである。

(0003) 図4の従来側はN型の半導体15とド型の・ 半導体16を交互に面列的に配列した熱電場子であり、 電流を通じると、金属板の一方が冷却され、他方が加熱 される。それらの金属板に配設された熱変換器17によって発気との熱交換を行なうことによって冷暖が用のヒートポンプとして明いられてきた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この従来型のヒートボンプデバイスの基本構成では、用いる無 30 世材料が有するゼーベック係数 (a) と電券度 (a)、および熱伝導率 (k) から決まる性能指数 (2; Z=a:-a/k) による効率の限界があり、現在最高の性能指数を有する BirTe: 系材料においても2-2.5×10・1/Kと小さく、効率が低いので、その実用化範囲は優めて限定されていた。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は電流を通じた 後、デバイスが定常状態に達する前に熱電材料の電流接 人部と説出部を空間的に分離するなどして両部を断熱す #/ ることによって、同じ熱或材料を用いながらヒートポン サデバイスの効率を飛躍的に向上させる手段としたもの である。

[0006]

基本的に効率を向上させることができない。しかしながら、図3において(a) (b) (c) の状態では、電流 放人部で発生したベルチュ熱は無信率によって拡散しな がらも混入部近傍にとどまっており、熱伝導によるベルチェ熱のロスは発生していない。一方、電腦設出部の冷却熱も同じ様な状態にある。そこで例えば (c) の状態 に達した時に通数を止め、熱量材料の高過部と低温部を 空間的に分離するなどして両値を断熱し、それぞれが熱 的平衡状態に達すると (c) のようになる。こうして熱 電材料理での熱以源に起因する熱ロスを大幅に低減することができるのでヒートボンブデバイスの効率を向上させることができる。

[0007] また、熱伝導による熱ロスを抑制できると、通電する時間と電液を両接することにより熱電材料をさらに満くできるので、ジュール熱による熱ロスも小さくでき、さらに効率を向上することが可能である。

(0008)

【実範例】以下に本発明による実施例を図面により説明する。図1は本発明による最も基本的なデバイス部分の一次範囲であり、その構成を示すものである。まず吸熱制の整理材料として基台1上にBirTex-ShrTer合金でできたP型半導体(図53mm)2と、電極として用いた剣プレート3を展気的に接続し、剣プレート上に熱交換フィントを開成した。東た。基台上に成けた送風ファン5によって無交換効率を上げた。回様に放無制としては吸熱制と対向する形でP型半導体(厚53mm)6、銅プレート7、熱交換フィン8を構成した。とらに基台部には駆動モーター9を取り付けることによって、吸熱側半導体の端面10と放熱網半導体の端面11の接続、切り組しが容易にできるようにした。また、それぞれのP型事導体には温度モニター用の熱電対12を電気的にP型事導体と絶縁して構成した。

【0009】このデバイスに、主ず端而10と端而11 を控続した状態で10A/c m² の電流を吸熱側半導体 2から放然例半導体6の方向に放した。次に通過後1秒 経た時、駅効モーター9によって吸熱制と放熱側の半導 体を離而から切り離すことによって互いに断熱した。安 囲気の退度を20℃にした場合、切り離し後約10秒料 て、それぞれの半導体内部で熱的に平衡状態に達した後 温度測定すると吸熱側半導体が17,5℃、放熱側半導 体が2.2。5℃となっており、冷却効率(C. O. P) は約7. 2であった。さらに通じる電流を100A/c mi とし、~0、1秒程度パルス的に放し、同時に半導 体の接続、切り離しをを行なうと平衡に達した後では吸 熱側半導体が16、0℃、放然側半導体が26、5℃と なっており、その時の効率は約20であった。この頂は 同じ熱電半導体 (7.=2.5×10-1/K) を、従来の定常状 妣で用いた場合と比べると10倍近く大きな値である。 切り醒した吸熱側、および放熱側半導体は熱交換フィン

熱交換した後、再び接続、通電、切り離しを繰り返した。 このような一緒の半導体を用いた木発明のデバイ、スを、例えばエアコン用ヒートボンブとして利用するためには、半導体料を複数製作つ構成にして順に冷房出力を取り出した方が使用であった。その結果連続的な冷却能力、あるいは加熱能力を有する高効率のヒートボンブを得ることができた。

【0010】この実施例として用いたBisTei-SbsTei-SbsTei-A然應材料は無伝導度、および環導度が比較的高いので、通電後の定常状態に達する時間が遅い。したがいてベルチェ無の無伝導による無ロスを防ぐためには、通電、切り種し時間の正確な研算が必要で、さらには比較的厚い無電材料が限ましい。そこで次により熱伝導度の低い2nSb系無電材料を用いて本発明によるデバイスの試作を行なった。通常後2秒で切り報すことにより約10での温度差をつけることができたが効率はやや低下した。また、電液需度を大きくしていくと短時間で大きな温度差が得られることも解った。このように用いる無電材料の物性値やヒートボンプの目的に応じて無電材料の別み上通電時間、電液需度を最適に設することが可なの関係の以外上通電時間、電液需度を最適に設することが可なの

【0011】本発明の実施例では、熱電材料の電流液大 朝と液出側とを断熱する最も具体的な手段として空間的 に分離した例を示したが、その他にも例えば印加する磁 場等によって熱伝導度が変わる熱電材料を吸熱器と放然 例との側に構成することによって、同様に高勤率のデバ イスを得ることも考えられる。

【0012】 従来の定常状態でのベルチニ効果を用いる ヒートボンプデバイスでは、ド型半導体とN型半導体を 交互に直列につなぐことによって、デバイス駆動に必要 30 な総電設量を少なくし、かつそれぞれの検点での映然、 収然を効率的に行なう構成になっている。本発明におい ても図2に示したようにド型半導体とN型半導体が直列

になるように構成することによって秘璃液盤を減らし、 電影端子を同じ側に配置することができた。

#### [0013]

【発明の街梨】以上のように本発明によるヒートボング デバイスは、従来、用いる熱質材料の性能指数で決定っ ていた効本の限界を越える性能指数の低さの故に限定さ れていた熱質現象の応用範囲を飛躍的に拡大するもので ある。

#### 【図版の間単な説明】

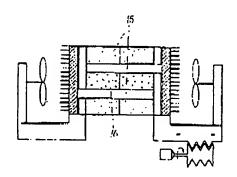
【図1】本発明の一実施例のヒートポンプデバイスの基本構成区

【142】 本発明の異なる総量設益を減らしたヒートポンプデバイスの構成は ・

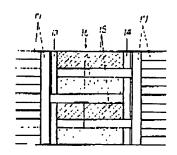
【図3】熱量材料内の温度分布の経時変化を表わす図 【図4】 従来のヒートボンプデバイスの構成図 【符号の説明】

- 1 基介
- 2 ド州半導体(岸さ3 mm)
- 3 知プレート
- 7 4 熱交換ツィン
  - 5 送風ファン
  - 6 上副市设体(内立3 mm)
  - 7 別プレート
  - 8 熱交換フィン
  - 駅効モーター
  - 10 吸熱樹半導体の端面
  - 1-1 放熱開半導体の縮面
  - 1.2 热熔材
  - 13 免帐权
- 14 255
- 15 N型半導体
- 16 P型半導体
- 17 热交烧器

(F421



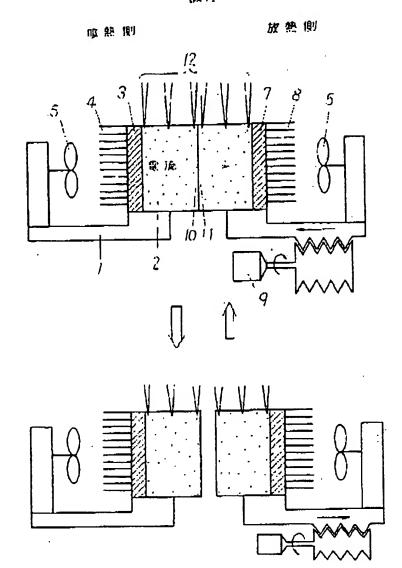
[[双-1]]



特開平5-39966

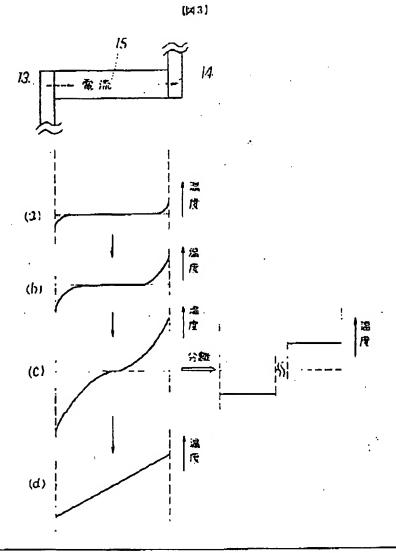
(4)

(tal 1 )



\$開平5-39966

(5)



ソロントベージの統合

(72) 范明者 中間 廣可 大阪府門真市大学門真1006番地。松下電器 **依案株式会社内**